

高周波、低消費電力 MEMSリレー

当社の高周波MEMSリレーは、圧電駆動方式を採用しており、低消費電力、高信頼性を兼ね備えています。当社独自の成膜技術により、薄さ1μmの圧電膜を実現したことで、低電圧駆動が可能になりました。半導体試験装置で実績を重ねてきた接点制御技術により、動作は信頼性が高く、高周波計測技術により、最大20GHzの高周波伝送に対応します。

■ MEMSリレーの用途



半導体検査装置、青波通信機器、西日本技術など

MEMSリレー製造工程



■当社の持つMEMS開発／製造力

開発拠点：アドバンテスト群馬R&Dセンター（群馬県邑楽郡伊勢崎町）
アドバンテスト研究所仙台市青葉区

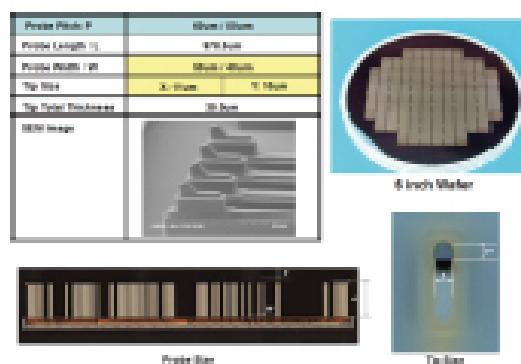
製造拠点：アドバンテスト コンポーネント（仙台市青葉区）
自社工場でMEMS関連製品や化合物半導体、高周波モ
ジュール向けSPU板を展開。

■ MEMSリレーの主な仕様値

周波数範囲：	DC-20GHz
駆動電圧：	12V
接点構成：	SPDT
サイズ(mm)：	5.4x4.2x0.9 2.9x3.4x0.9 の2種類
アイソレーション：	>20dB(-20GHz)
挿入損失：	<1dB(-20GHz)
特性インピーダンス：	50Ω

■ MEMSプローブピン

半導体ウエハに使用されるプローフカード用の針をMEMS技術を用いて作成しています。



■ アドバンテストについて

「計測と試験」における世界のリーディング・カンパニーとして、エレクトロニクス、情報通信、半導体製造といった、最先端の計測技術を必要とする産業で活躍しています。半導体・部品テスト・システム事業では、各種半導体デバイスの信頼性を支えるテスト・システムを提供し、世界で50%近くのシェアを持っています。

